

15aWH-6 強く二量化した系における電子相関の起源

理研・科学技術振興機構

田村雅史, 加藤礼三

The origin of on-site repulsion in a strongly dimerized system

RIKEN, JST-CREST

Masafumi Tamura, Reizo Kato

κ 型 ET 塩など二量体構造をもつ系の有効オンサイト斥力 U_{dimer} については, Hubbard 模型の結果を $t \ll U$ で近似した表式, $U_{\text{dimer}} = 2t + (1/2)[U - (U^2 + 16t^2)^{1/2}] \approx 2t$ (U は单量体分子のオンサイト斥力, t は二量体内の分子間 transfer) に基づいてしばしば議論され, 二量化の強さ (ここでは t) と有効斥力が比例していると見なされる. この線形化近似は $t \approx 0.1 U$ 程度まで有効だが, 二量化が強い $t > U/2$ ($[\text{Pd}(\text{dmit})_2]$ 塩などの場合) では U_{dimer} が t の関数として飽和し, 二量化の強さと電子相関が一見無関係になるよう見える. これは二量体内の分子間 Coulomb 斥力 V を考慮していないことによるものである. 拡張 Hubbard 模型で V の効果を取り入れれば, 二量化の強さと U_{dimer} が広いパラメーター領域で相関している.

拡張 Hubbard 模型で有効斥力は, 次の式で与えられる.

$$U_{\text{dimer}} = 2t + V + (1/2)[u - (u^2 + 16t^2)^{1/2}], \quad (u = U - V).$$

V も t も二量化に応じて変化するので, 二量化度を表す変数をはっきりさせる必要がある. 一般に二量化を特徴づける構造パラメーター x (例えば分子間距離) を使えば, 実験 (x の制御) に対応する U_{dimer} の二量化依存性は,

$$dU_{\text{dimer}}/dx = (\partial U_{\text{dimer}}/\partial t)(dt/dx) + (\partial U_{\text{dimer}}/\partial V)(dV/dx),$$

と書ける. 特に t で二量化度をはかるとすると, $x = t$ と考えて,

$$dU_{\text{dimer}}/dt = \partial U_{\text{dimer}}/\partial t + (\partial U_{\text{dimer}}/\partial V)(dV/dt),$$

が U_{dimer} の二量化依存性を表す. $t > U$ で $\partial U_{\text{dimer}}/\partial t \approx 0$ となっても, 第2項の寄与で U_{dimer} は二量化に応じて増加する.

この方法で U_{dimer} と二量化の関係を調べると, t/U の大小にあまり関係なく, U_{dimer} は二量化が強くなると増加することがわかる. その原因是, 二量体が狭くなると V が増えることによる U_{dimer} の増加である. $V = 0$ 近傍を除いて斥力の主な起源は V である. 同じ結論が, $[\text{Pd}(\text{dmit})_2]$ 塩のような HOMO-LUMO 二準位交差系でも導かれる. 二量体を1分子と見なしたときは二量体内の V が二量体全体の U のように見えるというごく自然な意味をもつ. 以上は, 実験的観点から構造と金属-絶縁体転移との対応関係を論じる際に注意を要する点であるが, 同時に有効なものといえる.